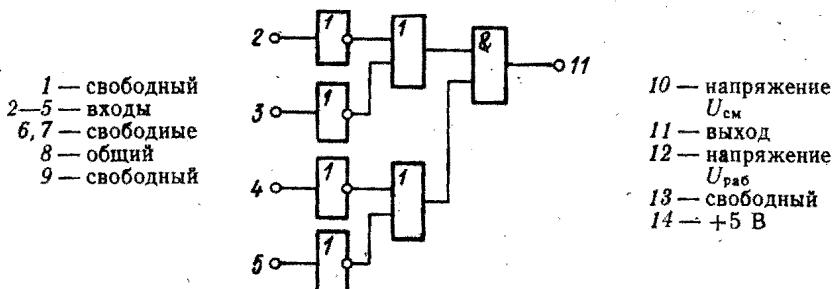


## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре  $25 \pm 5^\circ\text{C}$ )

Напряжение питания, В	$5 \pm 5\%$
Ток потребления, мА, не более:	
при низком уровне выходного напряжения	
по выводу 10	4
» » 14	5
при высоком уровне выходного напряжения	
по выводу 10	5,5
» » 14	5,5
Входной ток, мА:	
низкого уровня по выводам 2—5, не менее	минус 3,2
высокого уровня по выводам 2—5, не более	0,08
Выходной ток закрытой схемы, мА, не более	0,2
Остаточное напряжение, В	от 0,9 до 1,5
Время задержки распространения, нс, не более:	
при включении	65
» выключении	50

## ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное напряжение питания (кратковременно в течение 5 мс), В	7,5
Максимальное напряжение на выходе закрытой схемы (кратковременно в течение 5 мс), В	4,75

**ФОРМИРОВАТЕЛЬ ВТЕКАЮЩЕГО ТОКА НА 500 мА**

**170АА3**

Максимальное напряжение (кратковременно в течение 5 мс), В:

на выводе 10 . . . . . 33  
» » 12 . . . . . 31,5

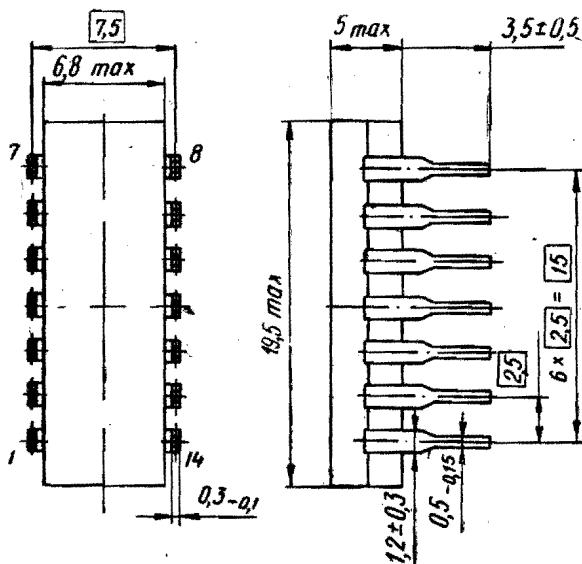
Максимальное входное напряжение (кратковременно в течение 5 мс), В . . . . . 5,25

Максимальный импульсный выходной ток (кратковременно в течение 5 мс), мА . . . . . 550

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 170

## Общие данные

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ (КОРПУС 201.14-2)



Масса не более 1 г

Нумерация выводов микросхем показана условно.

### ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

#### Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц . . . . .	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, м·с <sup>-2</sup> (g) . . . . .	400 (40)

#### Механический удар:

##### одиночного действия

пиковое ударное ускорение, м·с <sup>-2</sup> (g) . . . . .	10 000 (1000)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

##### многократного действия

пиковое ударное ускорение, м·с <sup>-2</sup> (g) . . . . .	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5

#### Линейное ускорение, м·с<sup>-2</sup> (g) . . . . .

5000 (500)

## МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 170

### Общие данные

Акустический шум:

диапазон частот, Гц . . . . .	50—10 000
уровень звукового давления, дБ . . . . .	160
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.):	
для микросхемы 170АП2 . . . . .	$1,3 \cdot 10^{-4}$ ( $10^{-6}$ )
» остальных микросхем . . . . .	665 (5)
Атмосферное повышенное давление, атм . . . . .	3
Повышенная температура среды, °С . . . . .	70
Поиниженная температура среды, °С . . . . .	минус 10
Изменения температуры окружающей среды, °С . . . . .	от минус 10 до +70
Повышенная относительная влажность при темпера-	
туре 35°C, % . . . . .	98
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

### НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка О, ч . . . . .	50 000
Срок сохраняемости О, лет . . . . .	25

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин «питание» и «земля») к выводам микросхем, используемым согласно схеме.

При ремонте аппаратуры и при контроле параметров микросхем в контактирующих устройствах замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

При работе с микросхемами должны быть приняты меры по защите от воздействия электростатического заряда.

Пределное значение электростатического потенциала 500 В.

О В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.